

Single

Schottky Barrier Diode

DE10P3

30V 10A

特長

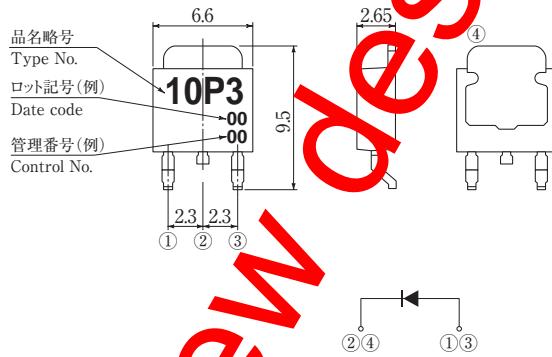
- SMD
- 高速スイッチング
- 低 V_F

Feature

- SMD
- High Recovery Speed
- Low V_F

■外観図 OUTLINE

Package : E-pack



外形図については新日本Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

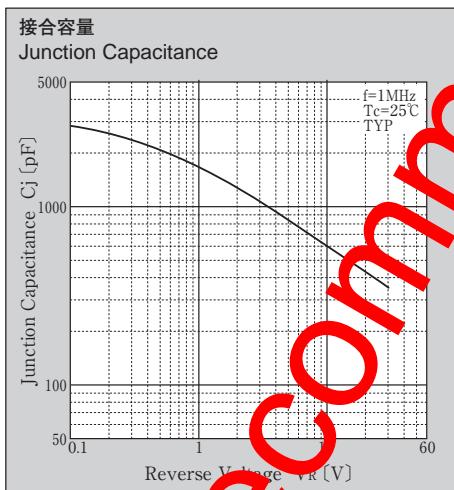
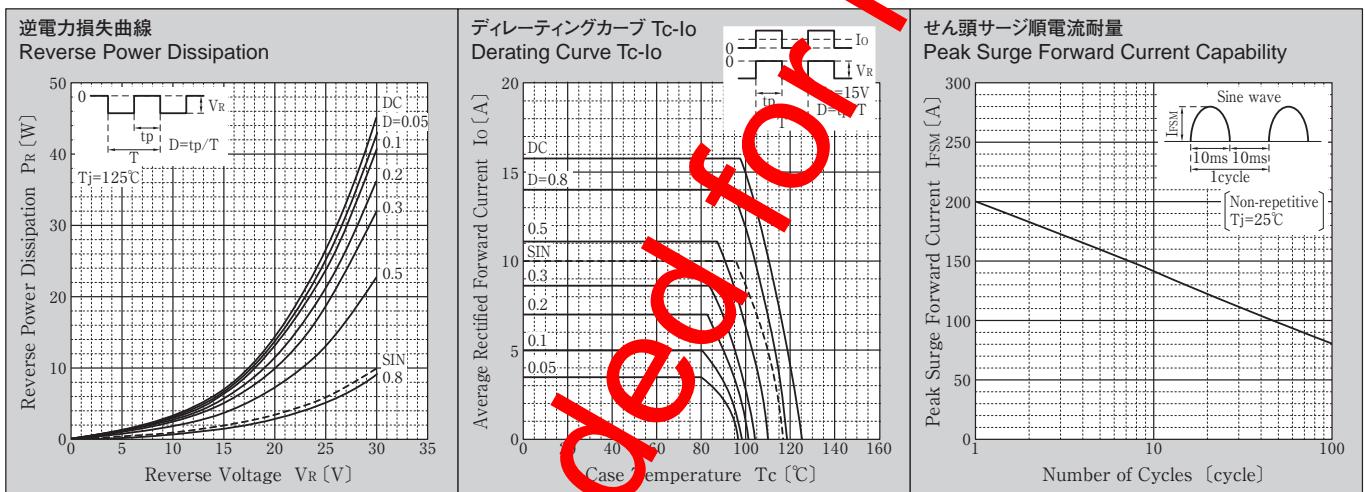
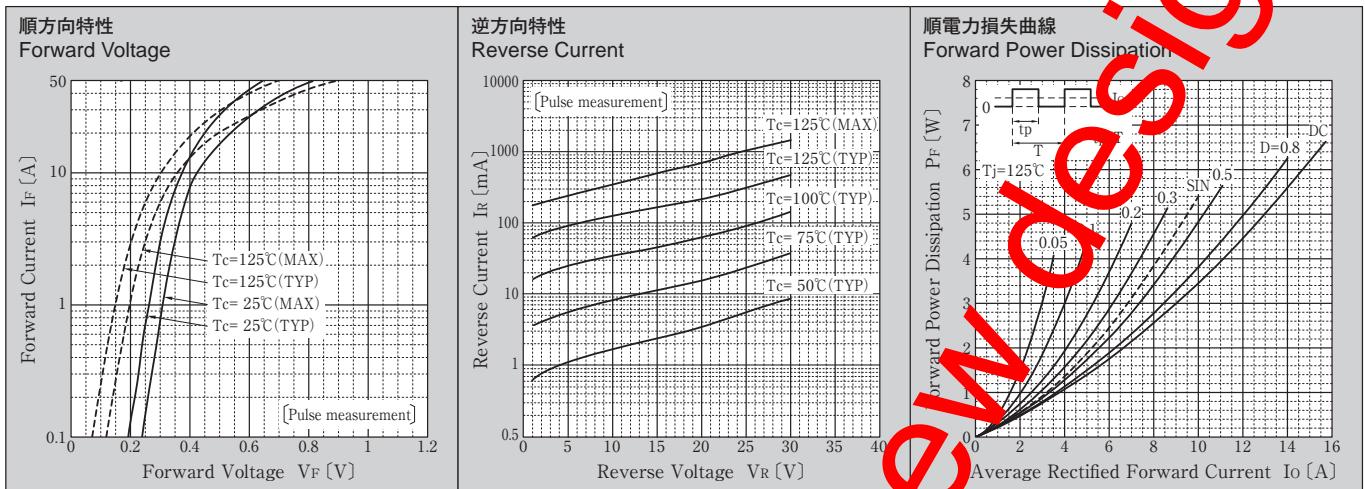
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$ /unless otherwise specified)

| 項目 Item | 記号 Symbol | 条件 Condition | 規格値 Ratings | 単位 Unit |
|---|------------|---|-------------|---------|
| 保存温度 Storage Temperature | Tstg | | -55~125 | °C |
| 接合部温度 Operating Junction Temperature | Tj | | 125 | °C |
| せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage | V_{RM} | | 30 | V |
| 繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage | V_{RRSM} | パルス幅 0.5ms, duty = 1/10 Pulse width 0.5ms, duty = 1/10 | 35 | V |
| 出力電流 Average Rectified Forward Current | I_o | 50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_c = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistive load, $T_c = 25^\circ\text{C}$ | 10 | A |
| せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current | I_{FSM} | 50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$ | 200 | A |

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$ /unless otherwise specified)

| | | | | |
|---------------------------|---------------|--|----------|------|
| 順電圧 Forward Voltage | V_F | $I_F = 8\text{A}$, パルス測定 Pulse measurement | MAX 0.40 | V |
| 逆電流 Reverse Current | I_R | $V_R = V_{RM}$, パルス測定 Pulse measurement | MAX 25 | mA |
| 接合容量 Junction Capacitance | C_j | $f = 1\text{MHz}$, $V_R = 10\text{V}$ | TYP 600 | pF |
| 熱抵抗 Thermal Resistance | θ_{jc} | 接合部～ケース間 junction to case | MAX 4.0 | °C/W |

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.